

PECVD 筆試題目

- 1、請寫出開始操作 PECVD 前所需檢查的事項
- 2、請概述 PECVD 的標準操作流程(步驟、使用 Recipe、存檔名稱、EPD 開關及操作中注意事項)
- 3、若想在 4 吋 Silicon Wafer 上長 500nm SiO₂ 及 SiN 各兩片，在不換 Holder 的情形下要如何操作?
- 4、在一個 Run 中 PECVD 成長薄膜的總厚度限制為何?該 Run 之 Final Claning 需要用哪一個 Recipe?
- 5、由於整個 Reactor 維持在 280 度，請寫出 Loading sample 的注意事項，及 Loading 對 Sample 所該做的處理及 sample 的限制。
- 6、請寫出操作儀器(PECVD)發生問題時的處理方式及停電時應該作何處理?
- 7、問 deposit SiO₂ 的氣體為何?deposit Si₃N₄ 的氣體為何?Cleaning 的氣體為何?
- 8、問機器的廠牌?
- 9、問機器的最高溫度為何?功率為何?機板尺寸?
- 10、問 PECVD 的廢氣處理方式?
- 11、請問 PECVD 在 VENT 時 vessel Gauge 及 Work Pressure 各為何?V5 valve 作用為何?在 VENT 時其工作機制為何??